(9) 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-143827

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和60年(1985)7月30日

B 01 J 19/12 G .03 F 1/00 H OI L 21/302 6542-4G Z-7447-2H

N-8223-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

遠紫外線光による表面処理装置

创特 顧 昭58-250088

会出 願 昭58(1983)12月28日

砂発 明 # 者 有

2

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

砂発 明 者 長 鳥

夫 笳

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地

①出 願 人 富士通株式会社

20代理

弁理士 松岡 宏四郎

1. 発明の名称

遠紫外線光による表面処理装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 直空容器内に遺業外線光源と、遺業外線 光を集光する手段とを配置し、該真空容器内で集 光した流雲外線光を試料に照射する様にしたこと を特徴とする遺紫外線光による表面処理装置。
- 3. 発明の詳細な説明
- 発明の技術分野

本発明は、ガラス基板、ホトマスク、ウェハー 等の試料の表面処理に係り、特に選紮外線を用い て試料の表面を洗浄する遺業外線光による裏面処 理装置に関するものである。

(2) 技術の背景

近年、試料表面洗浄の一つに遺業外線を用いる 方法が有る。これは184.9 nm. 253.7 nmの短波長の遺紫外線が大気中の酸素Oaを分 解し、オゾン(0g)と酸素原子(0)の活性酸 素を発生させるので、この活性酸素により試料衷

面に付着している有機系ダストが例えばCOzの 様な形に反応し灰化される事で試料表面を洗浄す る。また前配短波長の遮紮外線は有機系高分子ボ リマーのチェーンを切断し、低分子化する効果も 有している。しかしまだ十分に前記遠紫外線光の エネルギーが利用されていないのが現状である。

(3) 従来技術と問題点

従来, 試料表面を洗浄する為に、第1 図に示す 遺紫外線光を照射する装置が有る。この第1関に 於いて、適業外線光源1として例えば略30Wの 低圧水銀灯が水平に4個等間隔に設けられ、この 紫外線光源1からの遠紫外線が試料2以外に放射 しない様に遮蔽カバー3が散けられている。前記 装置は選業外線光微1より184、9ヵm、

2 5 3. 7 n m 等の強いスペクトルの波是の遺患 外線を放射し、この波長の遠紫外線で試料2の速 面の有概系高分子等を灰化、除去する。

しかしながら、装置は速紫外線光線1からの速 紫外線が大気中を経て試料2に照射されるので、 この選業外線は大気中で減衰する。特に184.

9 n m 波長は減衰が激しく低エネルギーとなり大 気中の酸素 (O z) の分解, 試料 2 の表面の有機 系高分子のポリマーの切断が有効に行なわれず, 試料 2 の表面の洗浄が完全に効率よく行なえない 問題を有していた。

(4) 発明の目的

本発明は上記従来の問題点に鑑み、選案外線光を減衰しない真空中で集光し高エネルギーにして 大気中の酸素 (〇 ²) を分解し、活性酸素を発生 させると共に直接試料表面に照射して試料を洗浄 する選案外線光による表面処理装置を提供する事 を目的とするものである。

(5) 発明の構成

そしてこの目的は本発明によれば真空容器内に 遠紫外線光源と、遠紫外線光を集光する手段とを 配置し、該真空容器内で集光した遠紫外線光を試 料に照射する様にしたことを特徴とする遠紫外線 光による表面処理装置を提供する事によって連成 される。

(.6) 発明の実施例

介して真空ポンプ等により例えば気圧が10⁻³T orr以下の真空状態とする。そして遺業外線光 銀1例えば184.9,253.7 nmに強いス ペクトルを持つ低圧水銀灯を点灯すると、選案外 線光が四方に放射される。遠紫外線光は一部直接 合成石英レンズ7に到達するが大部分半筒状の梅 円ミラー6で集光されて高エネルギーとなり繋外 雄を透過する合成石英レンズ?に入射する。前記 高エネルギーを得た遺紫外線光は前配合成石英レ ンズ1で更に収束し、矢印方向に扱送されて来た 試料2の表面の有機系ダスト。 高分子ポリマーの チェーンを切断し低分子化する。更に試料2と真 空容器 4 間の大気中の酸素 (0 1) は遺紫外線に より20 . →0 . + (0) に示す如く,オゾン(Oı)と原子状酸素(O)の活性酸素に分解され る。そして試料2の表面の有機系ダスト、低分子 化となった有機物は活性酸素と例えばCO:なる 形で反応してガス化され , 所謂灰化される。従 って184.9mm等の短波長の遠紫外線光は真 空中で減衰することなく,集光され高エネルギー

以下本発明の実施例を図面に基づいて群述する。 第2図(a)。(b)は本発明一実施例の選案外線光に よる表面処理装置の概略的断面図、斜視図である。 尚、第1図と同一部分には同一符号を付し重複説 明を省略する。

以上の構成で、先づ真空容器4内は排気管5を

となり試料2の表面を容易に洗浄する事ができる。 第3図は本発明の他の実施例の概略的断面図で ある。尚、第2図と同一部分には同一符号を付し、 盤複説明を省略する。

同図に於いて、第2図と異なる構成は遺紫外線 光源1と楕円ミラー6による反射光の熱線を分離 させるコールドミラー8とこの分離された熱線を 処理する熱交換器9が真空容器4内に設けられて いる点である。そして遺紫外線光源1と熱交換器 9の間に設けられているコールドミラー8は所定 の角度をもって半筒状の楕円ミラー6から遺紫 外線を反射し合成石英平板ガラス10を透過させ、 図示しない搬送装置により矢印方向に搬送されて 来たば料2の表面に照射させる。

第2図と同様に排気管5を介して真空ポンプ等により真空容器4内は気圧が10⁻³ Torr以下の真空状態にする。そして邀繁外線光源1としての例えば低圧水銀灯が点灯されると、邀繁外線光が放射され半筒状の楕円ミラー6で集光される。 集光される前記遠紫外線に含まれている熱線はコ

特開昭60-143827(3)

ールドミラー8で分離され熱交換器9で処理される。一方無線が除かれた前記選業外線は前記コールドミラー8で反射し、合成石英板ガラス10を透過して搬送されて来た試料2の表面に照射される。従って前記試料2は加熱される事もなくそして第2関同様に表面を洗浄される事になる。

(7) 発明の効果

以上、詳細に説明したように、本発明の選繁外 粮光による表面処理装置は低圧水銀灯等より 184.9 nm, 253.7 nm 波長の選繁外線 光を真空中で高エネルギーにしてガラス基板、ホ トマスク、ウェハー等の試料表面に照射するので、 試料表面に付着している有機系高分子ポリマーの サェーンを切断し低分子化すると共に大気中の酸 最を分解し、活性酸素のオゾンと酸素原子を発生 させて試料表面の有機系ダストを灰化させる洗浄 効果大なるものが有る。また他の実施例では試料 を余針な加熱なしに洗浄できる効果を有

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来例の邀繁外線光による裏面処理装

置の概略的断面図、第2図(A)(A)は本発明の一実施例である遠紫外線光による東面処理装置の概 的断面図と斜視図、第3図は本発明の他 実施例の概略的断面断面図である。

 1・・・選案外線光源
 2・・・試料

 3・・・鑑蔵カバー
 4・・・真空容器

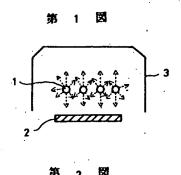
 5・・・排気管
 6・・・楕円ミラー

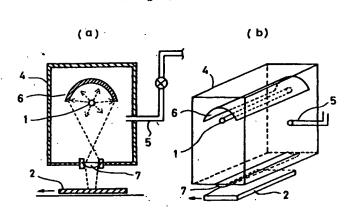
 7・・・合成石英レンズ
 8・・・コール

 ドミラー
 9・・・熱交換器

・・・合成石英板ガラス

特許出顧人 富士通株式会社 管整 代理人弁理士 松岡 宏四郎 容麗





第 2 図

